**Оптические свойства тонких пленок соединения In2Se3**

**Боднарь И.В.**

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

**Аннотация.** Методом ионно-лучевого испарения при температурах подложки 313 и 623 К получены пленки соединения In2Sе3. Oпределен состав и структура пленок. Установлено, что полученные пленки кристаллизуются в гексагональной структуре. По спектрам пропускания и отражения определена ширина запрещенной зоны (Eg) пленок In2Sе3, а также показателя преломления. Установлено, что с ростом температуры подложки Eg увеличивается.

**Ключевые слова:** пленки, спектры пропускания и отражения, ширина запрещенной зоны, показатель преломления.

Интернет-ссылка на статью:

<http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ftp>